

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0122U000605

Відкрита

Дата реєстрації: 26-01-2022

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 6541230

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1574.800

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2022	1574.800

2. Замовник

Назва організації: Національна академія наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270

Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна

Підпорядкованість:

Телефон: 380442343243

E-mail: prez@nas.gov.ua

WWW: <http://nas.gov.ua>

3. Виконавець

Назва організації: Інститут електронної фізики Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540008

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: вул. Університетська, буд. 21, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна

Телефон: 380312643524

Телефон: 380312643650

E-mail: nanu.iep@gmail.com

WWW: <http://www.iep.org.ua/>

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Фізико-хімічні аспекти формування напівпровідникових халькогенідних нанокристалів різної морфології у системах Bi(Sn)-As-S та Ag-In(Ga)-S і модифікація їх характеристик зміною технологічних параметрів одержання та іонізуючим випромінюванням

Назва роботи (англ)

Physical and chemical aspects of formation of semiconductor chalcogenide nanocrystals of various morphology in Bi(Sn)-As-S and Ag-In(Ga)-S systems and modification of their characteristics by variation of technological parameters of fabrication and ionizing radiation

Мета роботи (укр)

З'ясування умов формування напівпровідникових нанокристалів Bi2S3, SnS2 у матрицях на основі аморфного As2S3 в об'ємному та плівковому виді та нанокристалів системи Ag-In(Ga)-S у колоїдних розчинах і матрицях органічних полімерів та встановлення можливостей модифікації їх фізичних характеристик зміною технологічних параметрів одержання та впливом зовнішніх факторів, зокрема іонізуючим випромінюванням.

Мета роботи (англ)

Elucidation of conditions of formation of semiconductor nanocrystals Bi2S3 and SnS2 in amorphous As2S3 bulk and film-based matrices as well as Ag-In(Ga)-S nanocrystals in colloidal solutions and organic polymer matrices and figuring out possibilities for modification of their characteristics by variation of technological parameters of fabrication and external factors, in particular ionizing radiation.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології, Матеріали

Галузь застосування: Нові матеріали для створення елементної бази функціональних систем, зокрема при розробці фотовольтаїчних елементів, світлодіодних джерел світла, термоелектричних та фоточувливих систем

Експерти

Гомонай Ганна Миколаївна (д. ф.-м. н., член-кор.)

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	01.2022	12.2022	Остаточний звіт	Фізико-хімічні аспекти формування напівпровідникових халькогенідних нанокристалів різної морфології у системах Bi(Sn)-As-S та Ag-In(Ga)-S і модифікація їх характеристик зміною технологічних параметрів одержання та іонізуючим випромінюванням.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 53.41.43

Індекс УДК: 669:66-963, 621.315.59:539.24; 538.3

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Гомонай Ганна Миколаївна (д. ф.-м. н., член-кор.)

Керівники роботи:

Ажнюк Юрій Миколайович (д. ф.-м. н., пров.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Романова Л.Г. (Тел.: +38 (095) 496-50-50)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.